

2SD4 | 2

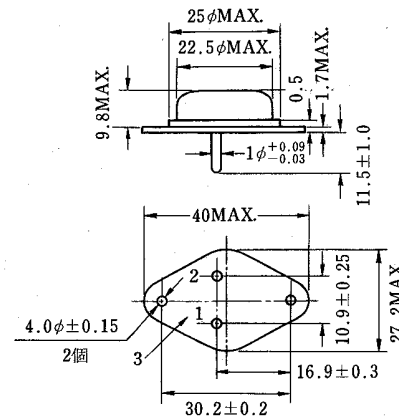
T N - 5 2 3 6

M A Y -30-75

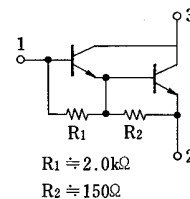
NPNエピタキシアルメサ形 シリコントランジスタ(ダーリントン接続)
低周波電力増幅および低速度スイッチング
通信工業用

- ダーリントン接続であるため直流電流増幅率が高い。
- コレクタ飽和電圧が低い。
- パルスモータドライバ、リレードライバ等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

外形図 / Outline (Unit : mm)



電極接続



1. Base
2. Emitter
3. Collector (Case)

EIAJ : TC-3, TB-3
JEDEC : TO-3
IEC : C14A, B18

* PW $\leq$ 10ms, duty cycle $\leq$ 50%

電氣的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100V, I_E=0$			100	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}	$V_{CE}=2.0V, I_C=15A$ *	1000	4000		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=15A, I_B=30mA$ *			1.5	V
ベ ー ス 飽 和 電 圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=15A, I_B=30mA$ *			2.2	V

*パルス測定/pulsed PW=350 μ s, duty cycle $\leq$ 2%